

## О ФОТОТОКЕ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ БЕЗ ЦЕНТРА СИММЕТРИИ

*П.М.Меднис*

В настоящей заметке сообщается, что, в отличие от обычной фотопроводимости, в полупроводниках без центра симметрии фототок возникает и в отсутствии постоянного поля. Действительно, в кристаллах без центра симметрии возможна связь между током и электромагнитным полем, квадратичная по полю, описываемая тензором кросспроводимости  $\sigma_{\mu\alpha\beta}(\omega_1, \omega_2)$ . Тогда фототок определяется тензором [1]

$$\sigma_{\mu\alpha\beta}(\omega, -\omega) = \frac{e}{2\hbar} \sum_{nk} f_n(k) \nabla_k^\mu \chi_{\beta\alpha}^{nk}(\omega). \quad (1)$$

Здесь  $\mu, \alpha, \beta$  – проекции на оси  $x, y, z$ ,  $e$  и  $\hbar$  – заряд электрона и постоянная Планка,  $f_n(k)$  – функция Ферми, нормированная на полное число электронов,  $n$  и  $\hbar k$  – номер зоны и квазиимпульс,  $\chi_{\beta\alpha}^{nk}(\omega)$  – линейная восприимчивость блоховского электрона в состоянии  $|nk\rangle = u_{nk} \exp(ikr)$  с энергией  $\epsilon_n(k)$ ,  $\omega$  – частота.

Механизм нелинейности, приводящий к указанному тензору – комбинированное движение электрона: внутризонно-межзонное движение [1]. Как следует из четности  $f_n(\mathbf{k})$  при  $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ , тензор (1) равен нулю при  $\alpha = \beta$  независимо от типа симметрии кристалла.

Далее рассмотрим частный случай волны, распространяющейся вдоль оси  $z$ , причем  $E_x = E_0 \cos \omega t$ ,  $E_y = E_0 \cos(\omega t + \phi)$ , где  $E_0$  – амплитуда поля,  $\phi$  – сдвиг фаз. Для определенности предположим, что имеется полупроводник с одной частично заполненной зоной проводимости ( $c$ -зона) и с остальными полностью заполненными валентными зонами ( $v$ -зоны). Тогда вклад валентных зон аддитивен и мы ограничимся учетом максимального вклада, полагая  $\omega \sim \omega_g$  и  $\omega \ll \omega'_g$ , где  $\omega_g$  и  $\omega'_g$  соответственно энергетические щели между  $c$ -зоной и учитываемой и между  $c$ -зоной и отброшенными валентными зонами. Заменяя суммирование по  $k$  интегрированием с функцией распределения для сильно вырожденного полупроводника, получим для плотности фототока.

$$i_\mu = -\frac{ie^3 n_0 \sin \phi E_0^2}{4\hbar^2} \left( \frac{\partial M_{xy}}{\partial k_\mu} \right) \left[ \frac{\omega_g - \omega + \Delta(k_F)}{(\omega_g - \omega + \Delta(k_F))^2 + \gamma^2} - \frac{\omega_g + \omega + \Delta(k_F)}{(\omega_g + \omega + \Delta(k_F))^2 + \gamma^2} \right], (2)$$

где  $n_0$  – концентрация электронов,  $\gamma$  – феноменологически введенная константа затухания  $k_F$  – квазимпульс, отвечающий границе заполнения зоны, а производная от величины

$$M_{xy}(\mathbf{k}) = \Omega_{cv}^x(\mathbf{k}) \Omega_{vc}^y(\mathbf{k}) - \Omega_{cv}^y(\mathbf{k}) \Omega_{vc}^x(\mathbf{k})$$

берется при  $\mathbf{k} = 0$ ,  $\Delta(k_F) = (\hbar / 2m_{cv}^*) k_F^2$ . Из (2) видно, что  $i_\mu$  пропорционально  $\sin \phi$ , т.е. фототок сильно зависит от относительного сдвига фаз между компонентами электрического поля. При  $\omega \ll \omega_g$ ,  $i_\mu \rightarrow 0$ . С ростом  $\omega$ ,  $i_\mu$  возрастает, а при  $\omega \gg \omega_g$  убывает как  $1/\omega$ . Максимальное значение  $i_\mu$  определяется также и величиной  $\Delta(k_F)$ , связанной с конечной шириной заполненного участка  $c$ -зоны. Указанные особенности явления позволят обнаружить его экспериментально. Численную оценку проведем, взяв параметры GaAs, для которого  $\omega_g = 2,1 \cdot 10^{15} \text{ рад} \cdot \text{сек}^{-1}$  ( $\hbar \omega_g = 1,37 \text{ эВ}$ ),  $n_0 = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . При частоте  $\omega = 1,8 \cdot 10^{15} \text{ рад} \cdot \text{сек}^{-1}$  ( $\hbar \omega = 1,17 \text{ эВ}$ , неодимовый лазер) сдвигом  $\Delta(k_F)$  и уширением  $\gamma$  можно пренебречь даже при комнатной температуре и в результате имеем

$$i_z = 3 \cdot 10^6 E_0^2 \gamma^{-1/2} \text{ см}^{1/2} (3)$$

В (3),  $E_0$  – размерная величина в системе СГСЭ. В практической системе единиц при  $E_0 \sim 10^4 \text{ в/см}$  получим, что  $i_z \sim 1 \text{ а/см}^2$ . Удобно ввести  $E_z^{\text{эфф}} = i_z / \sigma_0$ , где  $\sigma_0$  – статическая проводимость. Тогда

\* Матричные элементы  $\Omega_{cv}(\mathbf{k})$  определены, например, в [1]. Рассматриваем кристаллы с  $\Omega_{cc}(\mathbf{k}) = 0$ .

для монокристалла с длиной  $\ell$  вдоль оси  $z$  разность потенциалов на гранях  $U = E_z^{\text{эфф}} \ell$ . При  $\ell = 0,1 \text{ см}$ ,  $\sigma_0 \sim 10^2 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  получаем  $U \sim 10^{-3} \text{ в}$ , т.е. вполне наблюдаемую величину. Для полупроводников с узкой запрещенной зоной типа  $\text{InSb}$  подходящим источником может служить лазер на  $\text{CO}_2$  ( $\lambda = 10,6 \text{ мк}$ ). К новым особенностям фототока приводит приложенное магнитное поле  $H$ . В частности, уже для кубических кристаллов становятся возможными и направления фототока с  $\mu \neq z$ . Здесь укажем, что  $z$ -ая компонента  $j_z' = (j_z / n_0) Z(\zeta)$ , где  $\zeta = \epsilon_F / \hbar \omega_c$ ,  $\omega_c = eH / mc$  — циклотронная частота,  $m$  — эффективная масса в зоне проводимости, а  $\epsilon_F$  — уровень Ферми, отсчитанный от дна зоны.  $Z(\zeta)$  есть число состояний в единице объема с энергией меньших  $\epsilon_F$ , которое, как известно, осциллирует в зависимости от  $H^{-1}$ . Таким образом, в магнитном поле имеют место осцилляции фототока.

В заключение благодарю В.М.Файна и Э.И.Рашбу за обсуждение заметки, а также В.Н.Генкина и Э.Г.Ящина за ценные замечания.

Институт  
физики твердого тела  
Академии наук СССР

Поступило в редакцию  
26 февраля 1968 г.

#### Литература

[1] В.Н.Генкин, П.М.Меднис. ФТТ, 10, 3, 1968; ЖЭТФ, 54, 1137, 1968.

## ПУТЬ ПРЯМОГО НАБЛЮДЕНИЯ ГИГАНТСКИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ЯДРАХ ДЫРКОЙ В К-ОБОЛОЧКЕ

*В.И.Гольданский*

Вероятность испускания ядром частицы или кванта в некотором направлении зависит, как известно, в общем случае от угла между этим направлением и спином ядра  $I$  (при  $I \geq 1$ ). По этой причине при последовательном ядерном распаде  $A^a \rightarrow B^b \rightarrow C$  спины  $I_B$  промежуточных ядер  $B$  распределены в пространстве не изотропно относительно выделенного направления регистрации частицы  $a$ . Анизотропия же ориентации спинов  $I_B$  приводит к тому, что вероятность  $W$  совпадения регистрации двумя счетчиками  $C_a$  и  $C_b$  вылета частиц — соответственно  $a$  и  $b$  — зависит от угла  $\theta_{ab}$  между направлениями вылета:

$$W(\theta_{ab}) = \sum_{l=0}^{l_{\max}} a_l \cos^2 l \theta_{ab}.$$

где  $l_{\max}$  равняется удвоенному значению меньшей из трех величин —  $I_a$ ,  $I_b$  (моменты, уносимые частицами  $a$  и  $b$ ) и  $I_B$ .

Подобная корреляция между направлениями  $a$  и  $b$  нарушается (возмущение угловых корреляций) в том случае, когда за время жизни промежуточного ядра  $B$  ( $\tau_B$ ) успевает произойти заметная прецессия его